

Subject Name (Gujarati)

4353206 -- Winter 2024

Semester 1 Study Material

Detailed Solutions and Explanations

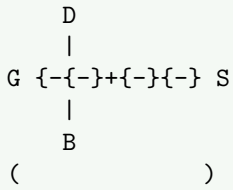
પ્રશ્ન 1(અ) [3 ગુણ]

એનહેન્સમેન્ટ અને ડીપ્લેશન ટાઈપ MOSFET માટે બધા સિમ્બોલ દોરો.

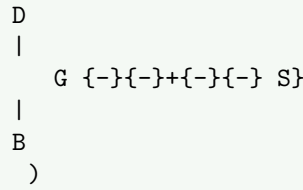
જવાબ

આકૃતિ:

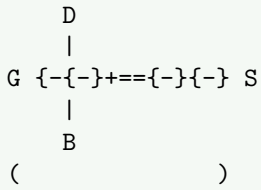
Enhancement Type NMOS:



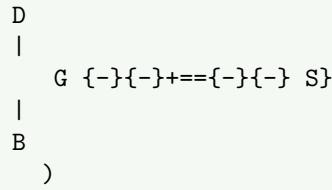
Enhancement Type PMOS:



Depletion Type NMOS:



Depletion Type PMOS:



- એનહેન્સમેન્ટ MOSFET: સોર્સ અને ડ્રેઇન વચ્ચે સામાન્ય કનેક્શન લાઇન
- ડીપ્લેશન MOSFET: અસ્તિત્વમાં રહેલ એનલ દર્શાવતી જાડી લાઇન
- એરો દિશા: NMOS માટે અંદરની તરફ, PMOS માટે બહારની તરફ

મેમરી ટ્રીક

“Enhancement ને વોલ્ટેજ જોઈએ, Depletion માં ડિફોલ્ટ એનલ”

પ્રશ્ન 1(બ) [4 ગુણ]

વ્યાખ્યા આપો: 1) હાઈરાસ્કી 2) રેગ્યુલારીટી

જવાબ

પરિભાષા	વ્યાખ્યા	ઉપયોગ
હાઈરાસ્કી	ટોપ-ડાઉન ડિઝાઇન અભિગમ જેમાં જટિલ સિસ્ટમને નાના, વ્યવસ્થિત મોડ્યુલમાં વિભાજિત કરાય છે	VLSI ડિઝાઇન ફ્લોમાં સિસ્ટમ લેવલથી ટ્રાન્ઝિસ્ટર લેવલ સુધી વપરાય છે
રેગ્યુલારીટી	જટિલતા ઘટાડવા માટે પુનરાવર્તિત સમાન સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરતી ડિઝાઇન તકનીક	મેમરી એરે, પ્રોસેસર ડેટાપાથમાં નિયમિત સ્ટ્રક્ચર વપરાય છે

- હાઈરાઈના ફાયદા: સરળ ડિઝાઇન વેરિફિકેશન, મોડ્યુલર ટેસ્ટિંગ, ટીમ કોલેબોરેશન
- રેગ્યુલારીટીના ફાયદા: ઓછો ડિઝાઇન સમય, બહેતર ચીલ્ડ, સરળ લેઆઉટ
- ડિઝાઇન ફ્લો: સિસ્ટમ → → RTL → →
- નિયમિત સ્ટ્રક્ચર: ROM એરે, કેશ મેમરી, ALU બ્લોક

મેમરી ટ્રીક

“હાઈરાઈકી હેલ્પ કરે ઓર્ગનાઇઝ કરવામાં, રેગ્યુલારીટી રિડ્યુસ કરે કોમ્પ્લેક્સિટી”

પ્રશ્ન 1(ક) [7 ગુણ]

MOS અન્ડર એક્સટર્નલ બાયસ સમજાવો.

જવાબ

MOS બાયસ કન્ડિશન કોષ્ટક:

બાયસ કન્ડિશન	ગેટ વોલ્ટેજ	ચેનલ નિર્માણ	કરંટ ફ્લો
એક્ચ્યુએશન	$V_G < 0$ (NMOS)	મેજોરિટી કેરિયર એકત્ર થાય છે	ચેનલ નથી
ડીપ્લેશન	$0 < V_G < V_T$	ડીપ્લેશન રીજન બને છે	ન્યૂનતમ કરંટ
ઇન્વર્શન	$V_G > V_T$	માઇનોરિટી કેરિયર ચેનલ બનાવે છે	ચેનલ વહન કરે છે

આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph LR
    A[ ] --{-{-}{-}} B\{ \}
    B --{-{-}{-}} VG {-} 0| C[ ]
    B --{-{-}{-}} 0 {-} VG {-} VT| D[ ]
    B --{-{-}{-}} VG {-} VT| E[ ]
    C --{-{-}{-}} F[ ]
    D --{-{-}{-}} G[ ]
    E --{-{-}{-}} H[ ]
{Highlighting}
{Shaded}
```

- બેન્ડ બેન્ડિંગ: એક્સટર્નલ વોલ્ટેજ ઓક્સાઇડ-સિલિકોન ઇન્ટરફેસ પર એનર્જી બેન્ડ વાળે છે
- થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ: ચેનલ નિર્માણ માટે જરૂરી ન્યૂનતમ ગેટ વોલ્ટેજ
- સરફેસ પોટેન્શિયલ: સિલિકોન સરફેસ પર કેરિયર કોન્સન્ટ્રેશન કંટ્રોલ કરે છે
- કેપેસિટન્સ વેરિએશન: બાયસ કન્ડિશન સાથે બદલાય છે

મેમરી ટ્રીક

“એક્ચ્યુએશન આકર્ષે, ડીપ્લેશન ડિપ્લીટ કરે, ઇન્વર્શન ઇન્વર્ટ કરે કેરિયર”

પ્રશ્ન 1(ક) OR [7 ગુણ]

સ્કેલિંગની શું જરૂરિયાત છે? સ્કેલિંગના ટાઈપ તેની ઈફેક્ટ સાથે સમજાવો.

જવાબ

સ્કેલિંગની જરૂરિયાત:

પેરામીટર	ફાયદો	પ્રભાવ
એરિયા રિડક્શન	ચિપ દીઠ વધુ ટ્રાન્ઝિસ્ટર	ઊંચી ઇન્ટિગ્રેશન ડેન્સિટી

સ્પીડ ઇન્ક્રીઝ	ઓછી ડીલે	બહેતર પરફોર્મન્સ
પાવર રિડક્શન	ઓછો પાવર વપરાશ	પોર્ટેબલ ડિવાઇસ
કોસ્ટ રિડક્શન	ફંક્શન દીઠ સસ્તું	માર્કેટ કોમ્પિટિટિવનેસ

સ્કેલિંગના પ્રકાર:

Mermaid Diagram (Code)

```

{Shaded}
{Highlighting}[]
graph LR
    A[MOSFET ] --{-}{-} B[ ]
    A --{-}{-} C[ ]
    B --{-}{-} D[ parameters ]
    C --{-}{-} E[ ]
    {Highlighting}
    {Shaded}

```

- કુલ વોલ્ટેજ સ્કેલિંગ: લેન્થ, વિડ્થ, વોલ્ટેજ બધું □ ફેક્ટર દ્વારા સ્કેલ
- કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજ સ્કેલિંગ: ડાઇમેન્શન સ્કેલ, વોલ્ટેજ અપરિવર્તિત
- પાવર ડેન્સિટી: કુલ સ્કેલિંગમાં કોન્સ્ટન્ટ રહે, કોન્સ્ટન્ટ વોલ્ટેજમાં વધે
- ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ: કુલ સ્કેલિંગમાં મેન્ટેઇન થાય છે

મેમરી ટ્રીક

“સ્કેલિંગ સેવ કરે સ્પેસ, સ્પીડ અને સ્પેન્ડિંગ”

પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

FPGA પર ટૂંકનોંધ લખો.

જવાબ

FPGA લાક્ષણિકતાઓ કોષ્ટક:

લક્ષણ	વર્ણન	ફાયદો
ફીલ્ડ પ્રોગ્રામેબલ ગેટ એરે	મેન્યુફેક્ચરિંગ પછી કોન્ફિગરેબલ લોજિક બ્લોકનું એરે	ડિઝાઇનમાં લવચીકતા પેરેલલ પ્રોસેસિંગ
રિકોન્ફિગરેબલ	ફરીથી પ્રોગ્રામ કરી શકાય	પ્રોટોટાઇપ ડેવલપમેન્ટ

- એપ્લિકેશન: ડિજિટલ સિગ્નલ પ્રોસેસિંગ, એમ્બેડેડ સિસ્ટમ, પ્રોટોટાઇપિંગ
- આર્કિટેક્ચર: CLBs (કોન્ફિગરેબલ લોજિક બ્લોક) રાઉટિંગ મેટ્રિક્સ દ્વારા કનેક્ટેડ
- પ્રોગ્રામિંગ: SRAM-આધારિત કોન્ફિગરેશન મેમરી
- વેન્ડર: Xilinx, Altera (Intel), Microsemi

મેમરી ટ્રીક

“FPGA: ફ્લેક્સિબલ પ્રોગ્રામિંગ ફોર ગેટ એરે”

પ્રશ્ન 2(બ) [4 ગુણ]

સેમી કસ્ટમ અને કુલ કસ્ટમ ડિઝાઇન મેથોડોલોજી સરખાવો.

પેરામીટર	સેમી-કસ્ટમ	ફુલ કસ્ટમ
ડિઝાઇન ટાઇમ	ઓછો (અઠવાડિયા)	વધુ (મહિના)
કોસ્ટ	ઓછો ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ	વધુ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ
પરફોર્મન્સ	મધ્યમ પરફોર્મન્સ	સર્વોચ્ચ પરફોર્મન્સ
એરિયા એફિશિયન્સી	ઓછી કાર્યક્ષમ	સૌથી કાર્યક્ષમ
એપ્લિકેશન	ASICs, મધ્યમ વોલ્યુમ	માઇક્રોપ્રોસેસર, ઊંચો વોલ્યુમ
ડિઝાઇન એફર્ટ	સ્ટાન્ડર્ડ સેલ વપરાય છે	દરેક ટ્રાન્ઝિસ્ટર ડિઝાઇન કરાય છે

- સેમી-કસ્ટમ: પ્રી-ડિઝાઇનડ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ અને ગેટ એરેનો ઉપયોગ કરે છે
- ફુલ કસ્ટમ: સંપૂર્ણ ટ્રાન્ઝિસ્ટર-લેવલ ડિઝાઇન ઓપ્ટિમાઇઝેશન
- ટ્રેડ-ઓફ: સમય વર્સિસ પરફોર્મન્સ, કોસ્ટ વર્સિસ એફિશિયન્સી
- માર્કેટ ફિટ: મોટાભાગના એપ્લિકેશન માટે સેમી-કસ્ટમ, સ્પેશિયલાઇઝડ જરૂરિયાત માટે ફુલ કસ્ટમ

મેમરી ટ્રીક

“સેમી-કસ્ટમ છે સ્ટાન્ડર્ડ, ફુલ કસ્ટમ છે ફાઇનેસ્ટ”

પ્રશ્ન 2(ક) [7 ગુણ]

1) $0 < V_{DS} < V_{DSAT}$ 2) $V_{DS} = V_{DSAT}$ 3) $V_{DS} > V_{DSAT}$ માટે MOSFET ઓપરેશન સમજાવો.

ઓપરેટિંગ રીજન:

રીજન	કન્ડિશન	ચેનલ	કરંટ બિહેવિયર
લિનિયર	$0 < V_{DS} < V_{DSAT}$	યુનિફોર્મ ચેનલ	$I_D \propto V_{DS}$
સેચ્યુરેશન ઓન્સેટ	$V_{DS} = V_{DSAT}$	પિંચ-ઓફ શરૂ થાય છે	મેક્સિમમ લિનિયર કરંટ
સેચ્યુરેશન	$V_{DS} > V_{DSAT}$	પિંચ ચેનલ	I_D કોન્સ્ટન્ટ

આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting} []
graph TD
    A[MOSFET] --> B[ ]
    A --> C[ ]
    B --> D[ ]
    B --> E[VDS]
    C --> F[ ]
    C --> G[ ]
{Highlighting}
{Shaded}
```

- લિનિયર રીજન: ચેનલ વોલ્ટેજ-કંટ્રોલ્ડ રેઝિસ્ટર તરીકે કામ કરે છે
- સેચ્યુરેશન રીજન: કરંટ માત્ર ગેટ વોલ્ટેજ દ્વારા કંટ્રોલ થાય છે
- V_{DSAT} કેલ્ક્યુલેશન: $V_{DSAT} = V_{GS} - V_T$
- કરંટ સમીકરણો: દરેક રીજન માટે અલગ મેથેમેટિકલ મોડેલ

મેમરી ટ્રીક

“લિનિયર લાઇક્સ V_{DS} , સેચ્યુરેશન સેઝ નો મોર”

પ્રશ્ન 2(અ) OR [3 ગુણ]

સ્ટાન્ડર્ડ સેલ બેઝડ ડિઝાઇન સમજાવો.

જવાબ

સ્ટાન્ડર્ડ સેલ ડિઝાઇન કોષ્ટક:

કમ્પોનન્ટ	વર્ણન	ફાયદો
સ્ટાન્ડર્ડ સેલ	પ્રી-ડિઝાઇનડ લોજિક ગેટ	ઝડપી ડિઝાઇન
સેલ લાઇબ્રેરી	કેટેગોરીઝેડ સેલનો સંગ્રહ	અનુમાનિત પરફોર્મન્સ
પ્લેસ એન્ડ રાઉટ	ઓટોમેટેડ લેઆઉટ જનરેશન	ઓછો ડિઝાઇન સમય

- પ્રોસેસ: લોજિક સિન્થેસિસ → → →
- સેલ પ્રકાર: બેસિક ગેટ, ફ્લોપ-ફ્લોપ, લેચ, કોમ્બિનેશન ફંક્શન
- ઓટોમેશન: EDA ટૂલ ફિઝિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન હેન્ડલ કરે છે
- કવોલિટી: બેલેન્સડ પરફોર્મન્સ, એરિયા અને પાવર

મેમરી ટ્રીક

“સ્ટાન્ડર્ડ સેલ સ્પીડ અપ કરે સિન્થેસિસ”

પ્રશ્ન 2(બ) OR [4 ગુણ]

Y ચાર્ટ દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

આકૃતિ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
    A[Y{- } {-}{-}{-} B[ ] ]
    A {-}{-}{-} C[ ] }
    A {-}{-}{-} D[ ] }
    B {-}{-}{-} E[ / ] }
    B {-}{-}{-} F[RTL/ ] }
    B {-}{-}{-} G[ / ] }
    C {-}{-}{-} H[ / ] }
    C {-}{-}{-} I[ALU/ ] }
    C {-}{-}{-} J[ / ] }
    D {-}{-}{-} K[ ] }
    D {-}{-}{-} L[ / ] }
    D {-}{-}{-} M[ / ] }
{Highlighting}
{Shaded}
```

ડોમેઇન	વર્ણન	ઉદાહરણ
બિહેવિયરલ	સિસ્ટમ શું કરે છે	એલ્ગોરિધમ, RTL કોડ
સ્ટ્રક્ચરલ	સિસ્ટમ કેવી રીતે બને છે	ગેટ, મોડ્યુલ, પ્રોસેસર
ફિઝિકલ	ફિઝિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન	લેઆઉટ, ફ્લોરપ્લાન, માર્ક

- ડિઝાઇન ફ્લો: બાહ્ય રિંગ (સિસ્ટમ) થી અંદરની રિંગ (ડિવાઇસ) તરફ જવું
- એબ્સ્ટ્રેક્શન લેવલ: દરેક રિંગ અલગ વિગતનું સ્તર દર્શાવે છે
- ડોમેઇન ઇન્ટરેક્શન: સમાન એબ્સ્ટ્રેક્શન પર ડોમેઇન વચ્ચે મૂલ્ય થઈ શકાય
- VLSI ડિઝાઇન: ત્રણેય ડોમેઇન અને એબ્સ્ટ્રેક્શન લેવલ કવર કરે છે

મેમરી ટ્રીક

“Y-ચાર્ટ: બિહેવિયર, સ્ટ્રક્ચર, ફિઝિકલ”

પ્રશ્ન 2(ક) OR [7 ગુણ]

MOSFET કરંટ-વોલ્ટેજ કેરેક્ટરિસ્ટિક માટે ગ્રેજુઅલ ચેનલ એપ્રોક્સિમેશન સમજાવો.

જવાબ

ધારણાઓ:

ધારણા	વર્ણન	જસ્ટિફિકેશન
ગ્રેજુઅલ ચેનલ	ચેનલ લેન્થ >> ચેનલ ડેપ્થ	લોંગ ચેનલ ડિવાઇસ
1D એનાલિસિસ	કરંટ માત્ર x-દિશામાં ફ્લો થાય છે	મેથેમેટિક્સ સરળ બનાવે છે
ડ્રિફ્ટ કરંટ	ડિફ્યુઝન કરંટ નેગલેક્ટ કરવો	હાઇ ફીલ્ડ કન્ડિશન
ચાર્જ શીટ	મોબાઇલ ચાર્જ પાતળી શીટમાં	નાની ઇન્વર્શન લેયર

કરંટ ડેરિવેશન:

- ડ્રેઇન કરંટ: $ID = \mu_n C_{ox} (W/L) [(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2/2]$
- લિનિયર રીજન: જ્યારે $V_{DS} < V_{GS} - V_T$
- સેચ્યુરેશન: જ્યારે $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$, $ID = \mu_n C_{ox} (W/2L) (V_{GS} - V_T)^2$
- ચેનલ ચાર્જ: સોર્સથી ડ્રેઇન સુધી લિનિયર રીતે વેરી થાય છે

મર્યાદાઓ:

- શોર્ટ ચેનલ ઇફેક્ટ: ગ્રેજુઅલ એપ્રોક્સિમેશન બ્રેક ડાઉન થાય છે
- વેલોસિટી સેચ્યુરેશન: હાઇ ફીલ્ડ ઇફેક્ટ ઇન્કલુડ નથી
- 2D ઇફેક્ટ: સિમ્પલ મોડેલમાં અવગણાય છે

મેમરી ટ્રીક

“ગ્રેજુઅલ ચેન્જ ગિવ સિમ્પલ ગેઇન એક્વેશન”

પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

આઈડલ ઇન્વર્ટરનો સિમ્બોલ દોરો અને ટ્રુથ ટેબલ લખો. આઈડલ ઇન્વર્ટર માટે VTC દોરો અને સમજાવો.

જવાબ

સિમ્બોલ અને ટ્રુથ ટેબલ:

VIN {--}{--}{--}{--}|o{--}{--}{--}{--} VOUT}
NOT

VIN	VOUT
0	1
1	0

VTC (વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફર કેરેક્ટરિસ્ટિક):

Diagram illustrating the input and output signals for the circuit:

- VOUT** is connected to the output of the circuit.
- VDD** is connected to the positive supply voltage.
- 0** is connected to ground.
- VDD/2** is connected to the input of the circuit.
- VDD** is connected to the input of the circuit.
- VIN** is connected to the input of the circuit.

- આઈડલ લાક્ષણિકતા: $V_{DD}/2$ પર તીવ્ર સંક્રમણ
- નોઈઝ માર્જિન: $NMH = NML = V_{DD}/2$
- ગેઇન: સ્વિચિંગ પોઇન્ટ પર અનંત
- પાવર કન્ઝમ્પશન: શૂન્ય સ્ટેટિક પાવર

મેમરી ટ્રીક

“આઈડલ ઇન્વર્ટર: અનંત ગેઇન, ઇન્સ્ટન્ટ સ્વિચિંગ”

પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

જનરાલાઇઝડ ઇન્વર્ટર સર્કિટ VTC સાથે સમજાવો.

જવાબ

સર્કિટ કોન્ફિગરેશન:

કમ્પોનન્ટ	ફંક્શન	લાક્ષણિકતા
ડ્રાઇવર ટ્રાન્ઝિસ્ટર લોડ ડિવાઇસ સપ્લાય વોલ્ટેજ	પુલ-ડાઉન ડિવાઇસ પુલ-અપ એલિમેન્ટ પાવર સોર્સ	સ્વિચિંગ કંટ્રોલ કરે છે હાઇ આઉટપુટ પ્રદાન કરે છે લોજિક લેવલ નક્કી કરે છે

VTC રીજન:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
    A[VTC ] --{} B[ 1: VOUT = VDD]}
    A --{} C[ 2: ]}
    A --{} D[ 3: VOUT = VOL]}
    B --{} E[ ]}
    C --{} F[ ]}
    D --{} G[ ]}
{Highlighting}
{Shaded}
```

- લોડ લાઇન એનાલિસિસ: ડ્રાઇવર અને લોડની લાક્ષણિકતાઓનું આંતરછેદ
- સ્વિચિંગ ગ્રેશોલ્ડ: ડિવાઇસ સાઇકલિંગ રેશિયો દ્વારા નક્કી થાય છે
- નોઇઝ માર્જિન: ટ્રાન્ઝિશન શાર્પનેસ પર આધાર રાખે છે
- પાવર ડિસિપેશન: ટ્રાન્ઝિશન દરમિયાન સ્ટેટિક કરંટ

મેમરી ટ્રીક

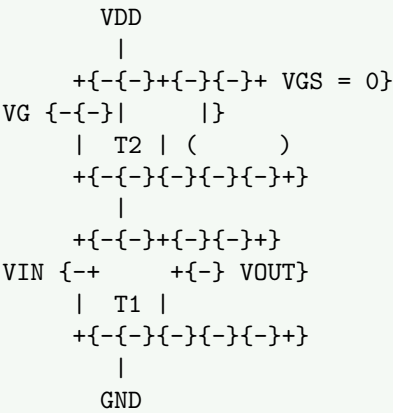
“જનરાલાઈઝ્ડ ડિઝાઇન: ડાઇવર પૂલ ડાઉન, લોડ લિફ્ટ અપ”

પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

ડીપ્લેશન લોડ nMOS ઇન્વર્ટર તેની સર્કિટ, ઓપરેટિંગ રીજન અને VTC સાથે સમજાવો.

જવાબ

સર્કિટ આકૃતિ:



ઓપરેટિંગ રીજન:

ઇનપુટ સ્ટેટ	T1 સ્ટેટ	T2 સ્ટેટ	આઉટપુટ
VIN = 0	બંધ	ચાલુ (ડીપ્લેશન)	VOUT = VDD-VT
VIN = VDD	ચાલુ	ચાલુ (રેઝિસ્ટિવ)	VOUT = VOL

VTC એનાલિસિસ:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
    A[VTC] --> B[VDD-VT]
    A --> C[VOL]
    A --> D[1]
    A --> E[0]
    A --> F[0]
    A --> G[0]
{Highlighting}
{Shaded}
```

- કુાયદા: સિમ્પલ ફેબ્રિકેશન, સારી ડ્રાઇવ કેપેબિલિટી
- નુકસાન: ડિગ્રેડેડ હાઇ આઉટપુટ, સ્ટેટિક પાવર કન્ઝમ્પશન
- એપ્લિકેશન: પ્રારંભિક NMOS લોજિક ફેમિલી
- ડિઝાઇન વિચારણા: વિડથ રેશિયો સ્વિચિંગ પોઇન્ટને અસર કરે છે

મેમરી ટ્રીક

“ડીપ્લેશન ડિવાઇસ ડિલિવર કરે ડીસેન્ટ ડ્રાઇવ”

પ્રશ્ન 3(અ) OR [3 ગુણ]

નોઇઝ માર્જિન સમજાવો.

જવાબ

વ્યાખ્યા અને પેરામીટર:

પેરામીટર	વર્ણન	ફોર્મ્યુલા
NMH	હાઇ નોઇઝ માર્જિન	$NMH = V_{OH} - V_{IH}$
NML	લો નોઇઝ માર્જિન	$NML = V_{IL} - V_{OL}$
VOH	આઉટપુટ હાઇ વોલ્ટેજ	મિનિમમ હાઇ આઉટપુટ
VOL	આઉટપુટ લો વોલ્ટેજ	મેક્સિમમ લો આઉટપુટ
VIH	ઇનપુટ હાઇ થ્રેશોલ્ડ	મિનિમમ ઇનપુટ હાઇ
VIL	ઇનપુટ લો થ્રેશોલ્ડ	મેક્સિમમ ઇનપુટ લો

- મહત્વ: સર્કિટની નોઇઝ સામે પ્રતિરોધકતાનું માપ
- ડિઝાઇન લક્ષ્ય: NMH અને NML બંનેને મેક્સિમાઇઝ કરો
- ટ્રેડ-ઓફ: નોઇઝ માર્જિન વર્સિસ સ્પીડ વર્સિસ પાવર
- એપ્લિકેશન: ડિજિટલ સિસ્ટમ ડિઝાઇનમાં મહત્વપૂર્ણ

મેમરી ટ્રીક

“નોઇઝ માર્જિન મેઇન્ટેઇન કરે સિગ્નલ ઇન્ટેગ્રિટી”

પ્રશ્ન 3(બ) OR [4 ગુણ]

રેઝિસ્ટિવ લોડ ઇનવર્ટર સમજાવો.

જવાબ

સર્કિટ અને એનાલિસિસ:

કમ્પોનન્ટ	ફંક્શન	લાક્ષણિકતા
NMOS ટ્રાન્ઝિસ્ટર	સ્વિચિંગ ડિવાઇસ	વેરિએબલ રેઝિસ્ટન્સ
લોડ રેઝિસ્ટર	પુલ-અપ એલિમેન્ટ	ફિક્સ્ડ રેઝિસ્ટન્સ RL
પાવર સપ્લાય	વોલ્ટેજ સોર્સ	VDD પ્રદાન કરે છે

ઓપરેટિંગ પ્રિન્સિપલ:

- હાઇ ઇનપુટ: ટ્રાન્ઝિસ્ટર ચાલુ, $V_{OUT} = V_{DD} - I_D \times R_L$
- લો ઇનપુટ: ટ્રાન્ઝિસ્ટર બંધ, $V_{OUT} = V_{DD}$ (હાઇ)
- કરંટ પાથ: આઉટપુટ લો હોય ત્યારે હંમેશા રેઝિસ્ટર દ્વારા
- પાવર કન્ઝમ્પશન: સ્ટેટિક પાવર = V_{DD}^2 / R_L

ફાયદા અને નુકસાન:

- સિમ્પલ ડિઝાઇન: સમજવામાં અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં સરળ
- ખરાબ પર્ફોર્મન્સ: હાઇ સ્ટેટિક પાવર, સ્લો સ્વિચિંગ
- મર્યાદિત ઉપયોગ: મુખ્યત્વે કોન્સેપ્ટ સમજવા માટે

મેમરી ટ્રીક

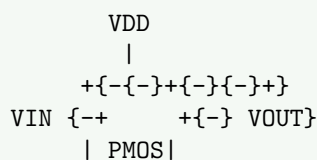
“રેઝિસ્ટર રિસ્ટ્રિક્ટ કરે કરંટ, રિઝયુસ કરે પર્ફોર્મન્સ”

પ્રશ્ન 3(ક) OR [7 ગુણ]

CMOS ઇનવર્ટર તેની VTC સાથે સમજાવો.

જવાબ

સર્કિટ કોન્ફિગરેશન:



$$V_{IN} \{-+\}$$

રીજન	ઇનપુટ રેન્જ	PMOS સ્ટેટ	NMOS સ્ટેટ	આઉટપુટ
1	$V_{IN} < V_{TN}$	ચાલુ	બંધ	VDD
2	$V_{TN} < V_{IN} < V_{DD}/2$	ચાલુ	ચાલુ	ટ્રાન્ઝિશન
3	$V_{DD}/2 < V_{IN} < V_{DD}+V_{TP}$	ચાલુ	ચાલુ	ટ્રાન્ઝિશન
4	$V_{IN} > V_{DD}+V_{TP}$	બંધ	ચાલુ	0

Mermaid Diagram (Code)

- કોમ્પ્લેક્સ-નરી ઓપરેશન: સ્ટેડી સ્ટેટમાં માત્ર એક ટ્રાન્ઝિસ્ટર વહન કરે છે
- સ્વિચિંગ પોઇન્ટ: PMOS/NMOS રેશિયો દ્વારા નક્કી થાય છે
- પાવર એફિશિયન્સી: ન્યૂનતમ સ્ટેટિક પાવર કન્ઝમ્પશન
- નોઇઝ ઇમ્યુનિટી: ઉત્તમ નોઇઝ માર્જિન

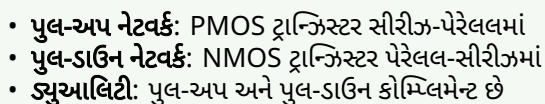
“CMOS: કોમ્પિલમેન્ટરી ફોર કોમ્પ્લીટ પરફોર્મન્સ”

Diagram illustrating a CMOS circuit structure with PMOS and NMOS transistors connected to VDD and ground.

The circuit consists of two PMOS transistors (A and B) and one NMOS transistor (A{B}).

The PMOS transistors are connected to VDD and their gates are driven by the input signal A. The NMOS transistor is connected to ground and its gate is driven by the input signal B.

The output of the circuit is taken from the node between the PMOS and NMOS transistors.



```

      |      |
      +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-} VOUT}
      |
      +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}
A {-{-}{-}|      |}
  | NMOS| ( )
  +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}
  |
  +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}
B {-{-}{-}|      |}
  | NMOS|
  +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}
  |
  GND

```

ટ્રુથ ટેબલ:

A	B	NOR	NAND
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	0

મેમરી ટ્રીક

“NOR ને કંઈ હાઇ નહીં જોઈએ, NAND ને બધું હાઇ જોઈએ લો થવા માટે”

પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

NOR2 અને NAND2 ગેટનો ઉપયોગ કરીને CMOS SR લેચ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો.

જવાબ

NOR ગેટ વડે SR લેચ:

```

S {-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-} [NOR] {-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-} Q}
  |      |
  +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-} |}
  |      |
  +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-} |}
  |      |
R {-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-} [NOR] {-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-} Q}
  |
  +{-{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}{-}

```

CMOS NOR ગેટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન:

Mermaid Diagram (Code)

```

{Shaded}
{Highlighting}[]
graph TD
A[SR ] {-{-}{-}{-} B[ :
S=1,
R=0]]}
A {-{-}{-}{-} C[ :
S=0,

```

R=1]]}

A {-{-}-{-}} D[:

S=0,

R=0]]}

A {-{-}-{-}} E[:

S=1,

R=1]]}

B {-{-}-{-}} F[Q=1, Q{}=0]]}

C {-{-}-{-}} G[Q=0, Q{}=1]]}

D {-{-}-{-}} H[]]]}

E {-{-}-{-}} I[=0, !]]}

{Highlighting}

{Shaded}

સ્ટેટ ટેબલ:

S	R	Q(n+1)	Q'(n+1)	એક્શન
0	0	Q(n)	Q'(n)	હોલ્ડ
0	1	0	1	રીસેટ
1	0	1	0	સેટ
1	1	0	0	અમાન્ય

- ક્રોસ-ક્લ્ડ સ્ટ્રક્ચર: દરેક ગેટનું આઉટપુટ બીજાના ઇનપુટને ફીડ કરે છે
- બાઇસ્ટેબલ ઓપરેશન: બે સ્થિર અવસ્થા (સેટ અને રીસેટ)
- મેમરી એલિમેન્ટ: એક બિટ માહિતી સ્ટોર કરે છે
- કલોક ઇન્ડિપેન્ડન્સ: એસિંક્રોનસ ઓપરેશન

મેમરી ટ્રીક

“SR લેય: સેટ-રીસેટ વિથ ક્રોસ-ક્લ્ડ ગેટ”

પ્રશ્ન 4(અ) OR [3 ગુણ]

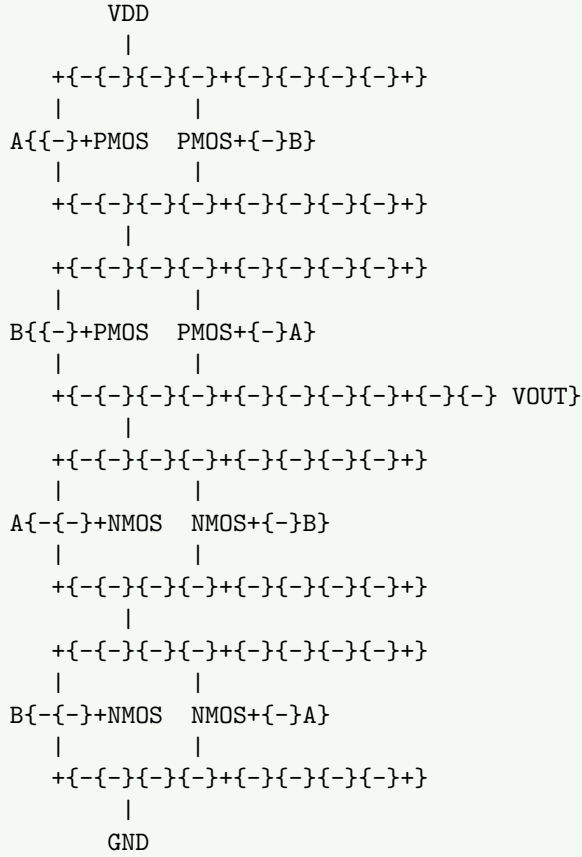
CMOS નો ઉપયોગ કરીને XOR ફંક્શન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો.

જવાબ

XOR ટ્રુથ ટેબલ:

A	B	Y = A
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

CMOS XOR ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન:



- ફંક્શન: $Y = AB' + A'B$
- ટ્રાન્ઝિસ્ટર કાઉન્ટ: 8 ટ્રાન્ઝિસ્ટર (4 PMOS + 4 NMOS)
- વિકલ્પ: ટ્રાન્સમિશન ગેટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન

મેમરી ટ્રીક

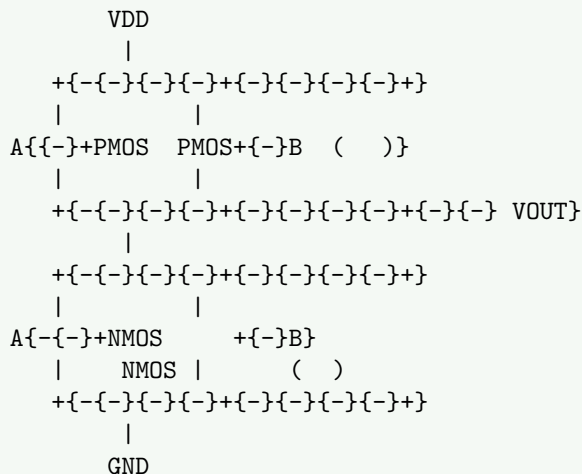
“XOR: એક્સક્લુસિવ OR, અલગ ઇનપુટ આપે 1”

પ્રશ્ન 4(બ) OR [4 ગુણ]

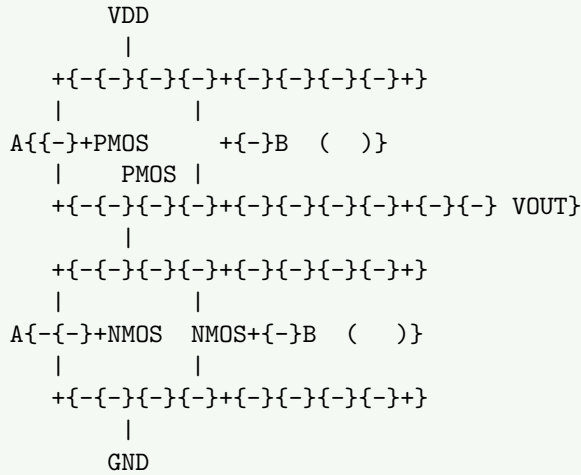
બે ઇનપુટ NOR અને NAND ગેટ CMOS થી બનાવો.

જવાબ

CMOS NOR ગેટ:



CMOS NAND ગેટ:



ડિઝાઇન નિયમો:

ગેટ	પુલ-અપ નેટવર્ક	પુલ-ડાઉન નેટવર્ક
NAND	PMOS પેરેલલમાં	NMOS સીરીઝમાં
NOR	PMOS સીરીઝમાં	NMOS પેરેલલમાં

મેમરી ટ્રીક

“NAND: નોટ AND, NOR: નોટ OR - નેટવર્ક કોમ્પ્લિમેન્ટ કરો”

પ્રશ્ન 4(ક) OR [7 ગુણ]

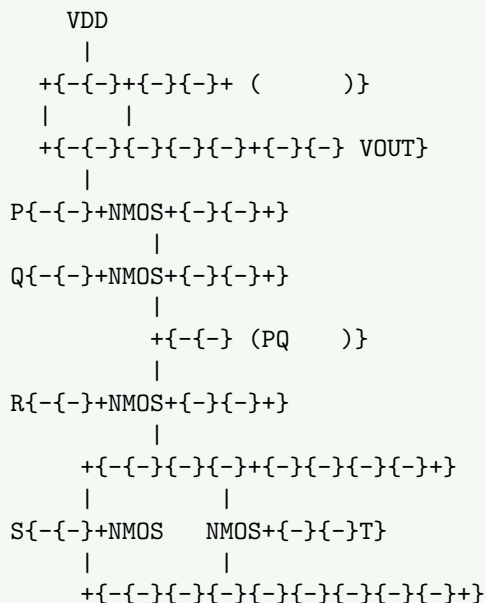
$Y = [PQ + R(S+T)]'$ બુલિયન સમીકરણ ડીપ્લેશન લોડ nMOS અને CMOS થી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો.

જવાબ

બુલિયન એનાલિસિસ:

- ફંક્શન: $Y = [PQ + R(S+T)]'$
- વિસ્તૃત: $Y = [PQ + RS + RT]'$
- ડે મોર્ગન: $Y = (PQ)' \cdot (RS)' \cdot (RT)'$
- અંતિમ: $Y = (P'+Q') \cdot (R'+S') \cdot (R'+T')$

nMOS ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન:



|
GND

CMOS ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન:

Mermaid Diagram (Code)

```
{Shaded}
{Highlighting} []
graph LR
    A[CMOS ] --{-}{-} B[ {-} : PMOS]
    A --{-}{-} C[ {-} : NMOS]
    B --{-}{-} D[ {-} ]
    C --{-}{-} E[ ]
    D --{-}{-} F[ {-} ]
    E --{-}{-} G[ {-} ]
{Highlighting}
{Shaded}
```

- **nMOS લાક્ષણિકતા:** સિમ્પલ પણ સ્ટેટિક પાવર સાથે
- **CMOS ફાયદા:** સ્ટેટિક પાવર નથી, કુલ સ્વિંગ
- **જટિલતા:** nMOS માટે 7 ટ્રાન્ઝિસ્ટર, CMOS માટે 14
- **પરફોર્મન્સ:** CMOS ઝડપી અને વધુ કાર્યક્ષમ

મેમરી ટ્રીક

“બુલિયન ટુ સર્કિટ: nMOS સિમ્પલ, CMOS કોમ્પ્લીટ”

પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

વેરિલોગમાં ઉપયોગ થતી ડિઝાઇન સ્ટાઇલ સમજાવો.

જવાબ

વેરિલોગ ડિઝાઇન સ્ટાઇલ:

સ્ટાઇલ	વર્ણન	એપ્લિકેશન
ગેટ લેવલ	પ્રિમિટિવ ગેટનો ઉપયોગ	લો-લેવલ હાર્ડવેર મોડેલિંગ
ડેટા ફ્લો	assign સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ	કોમ્પિનેશનલ લોજિક
બિહેવિયરલ મિક્સડ	always બ્લોકનો ઉપયોગ સ્ટાઇલનું કોમ્પિનેશન	સિક્વેન્શિયલ અને કોમ્બિનેશનલ લોજિક સંપૂર્ણ સિસ્ટમ ડિઝાઇન

- **ગેટ લેવલ:** and, or, not, nand, nor પ્રિમિટિવ
- **ડેટા ફ્લો:** ઓપરેટર સાથે કંટિન્યુઅસ એસાઇનમેન્ટ
- **બિહેવિયરલ:** always બ્લોકમાં પ્રોસિજરલ એસાઇનમેન્ટ
- **હાઇરાઇબ્રિડ:** મોડ્યુલ અલગ સ્ટાઇલ વાપરી શકે છે

મેમરી ટ્રીક

“ગેટ-ડેટા-બિહેવિયર: મોડેલ કરવાની ત્રણ રીત”

પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

બિહેવિયરલ મોડેલિંગ થી કુલ એડર માટે વેરિલોગ પ્રોગ્રામ લખો.

જવાબ

```
module full_adder_behavioral (
    input wire a, b, cin,
    output reg sum, cout
);

always @(*) begin
    case ({a, b, cin})
        3'b000: {cout, sum} = 2'b00;
        3'b001: {cout, sum} = 2'b01;
        3'b010: {cout, sum} = 2'b01;
        3'b011: {cout, sum} = 2'b10;
        3'b100: {cout, sum} = 2'b01;
        3'b101: {cout, sum} = 2'b10;
        3'b110: {cout, sum} = 2'b10;
        3'b111: {cout, sum} = 2'b11;
        default: {cout, sum} = 2'b00;
    endcase
end

endmodule
```

મુખ્ય લક્ષણો:

- **Always બ્લોક:** બિહેવિયરલ મોડેલિંગ કન્સ્ટ્રક્ટ
- **Case સ્ટેટમેન્ટ:** ટ્રુથ ટેબલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન
- **કોનકેટેનેશન:** કોમ્બાઇન આઉટપુટ માટે {cout, sum}
- **સેન્સિટિવિટી લિસ્ટ:** કોમ્બિનેશનલ લોજિક માટે @(*)

મેમરી ટ્રીક

“બિહેવિયરલ યુઝ કરે Always વિથ Case સ્ટેટમેન્ટ”

પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

CASE સ્ટેટમેન્ટનું ફંક્શન વર્ણવો. CASE સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને 3x8 ડિકોડરનો વેરિલોગ કોડ લખો.

જવાબ

CASE સ્ટેટમેન્ટ ફંક્શન:

લક્ષણ	વર્ણન	ઉપયોગ
મલ્ટિ-વે બ્રાન્ચ પેટર્ન મેચિંગ	અનેક વિકલ્પોમાંથી એક પસંદ કરે	C માં switch જેવું બરાબર બિટ મેચિંગ
પ્રાયોરિટી એન્કોડિંગ	પહેલું મેચ જીતે છે	ટોપ-ડાઉન ઇવેલ્યુએશન
ડિકોલ્ટ કલોઝ	અનસ્પેસિફાઇડ કેસ હેન્ડલ કરે	લેય અટકાવે છે

3x8 ડિકોડર વેરિલોગ કોડ:

```
module decoder\_3x8 (  
    input wire [2:0] select,  
    input wire enable,  
    output reg [7:0] out  
);  
  
always @(*) begin  
    if (enable) begin  
        case (select)  
            3{b000}: out = 8{b00000001};  
            3{b001}: out = 8{b00000010};  
            3{b010}: out = 8{b00000100};  
            3{b011}: out = 8{b00001000};  
            3{b100}: out = 8{b00010000};  
            3{b101}: out = 8{b00100000};  
            3{b110}: out = 8{b01000000};  
            3{b111}: out = 8{b10000000};  
            default: out = 8{b00000000};  
        endcase  
    end else begin  
        out = 8{b00000000};  
    end  
end  
  
endmodule
```

CASE સ્ટેટમેન્ટ લક્ષણો:

- બરાબર મેચિંગ: બધા બિટ બરાબર મેચ થવા જોઈએ
- પેરેલલ ઇવેલ્યુએશન: હાર્ડવેર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પેરેલલ છે
- સંપૂર્ણ સ્પેસિફિકેશન: બધા શક્ય ઇનપુટ કોમ્બિનેશન કવર કર્યા
- ડિફોલ્ટ કલોઝ: સિન્ટેસિસમાં અનઇન્ટેન્ડેડ લેય અટકાવે છે

મેમરી ટ્રીક

“CASE કોમ્પેર કરે બધું સ્પેસિફાઇડ એક્ઝેક્યુટલી”

પ્રશ્ન 5(અ) OR [3 ગુણ]

2:1 મલ્ટિપ્લેક્સર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતો વેરિલોગ કોડ લખો.

જવાબ

```
module mux\_2to1 (  
    input wire a, b, sel,  
    output wire y  
);  
  
assign y = sel ? b : a;  
  
endmodule
```

વિકલ્પિત ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન:

સ્ટાઇલ	કોડ	ઉપયોગ કેસ
ડેટા ફ્લો	assign y = sel ? b : a;	સિમ્પલ લોજિક
ગેટ લેવલ	and, or, not ગેટ વાપરે	શીખવાનો હેતુ
બિહેવિયરલ	if-else સાથે always બ્લોક	કોમ્પ્લેક્સ કન્ડિશન

- કન્ડિશનલ ઓપરેટર: ? : મલ્ટિપ્લેક્સર ફંક્શન પ્રદાન કરે
- કંટિન્યુઅસ એસાઇનમેન્ટ: કોમ્પિલેશનલ લોજિક માટે assign
- સિન્થેસિસ: ટૂલ ગેટ-લે I/O ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં કન્વર્ટ કરે

મેમરી ટ્રીક

“MUX: sel ? b : a - ઇનપુટ વચ્ચે પસંદગી”

પ્રશ્ન 5(બ) OR [4 ગુણ]

બિહેવિયરલ મોડેલિંગ થી D ફ્લિપ-ફ્લોપ માટે વેરિલોગ પ્રોગ્રામ લખો.

જવાબ

```
module d\_flipflop (
    input wire clk, reset, d,
    output reg q, qbar
);

always @(posedge clk or posedge reset) begin
    if (reset) begin
        q {=} 1'b0;
        qbar {=} 1'b1;
    end else begin
        q {=} d;
        qbar {=} ~d;
    end
end

endmodule
```

મુખ્ય લક્ષણો:

એલિમેન્ટ	ફંક્શન	સિન્ટેક્સ
posedge clk	રાઇઝિંગ એજ ટ્રિગર	ક્લોક સિન્ક્રોનાઇઝેશન
posedge reset	એસિન્ક્રોનસ રીસેટ	તાત્કાલિક રીસેટ એક્શન
નોન-બ્લોકિંગ	<= ઓપરેટર	સિક્વેન્શિયલ લોજિક
કોમ્પિલમેન્ટરી	qbar = ~q	સાચી ફ્લિપ-ફ્લોપ બિહેવિયર

- એજ સેન્સિટિવિટી: માત્ર ક્લોક એજ પર પ્રતિભાવ આપે
- એસિન્ક્રોનસ રીસેટ: રીસેટ ક્લોક કરતાં પ્રાથમિકતા લે
- સિક્વેન્શિયલ લોજિક: નોન-બ્લોકિંગ એસાઇનમેન્ટ વાપરે
- સ્ટેટ સ્ટોરેજ: ક્લોક સાઇકલ વચ્ચે ડેટા જાળવે

મેમરી ટ્રીક

“D ફ્લિપ-ફ્લોપ: ડેટા ફ્લો કરે ક્લોક વિથ રીસેટ”

પ્રશ્ન 5(ક) OR [7 ગુણ]

ટેસ્ટબેંચ ટૂંકમાં વર્ણવો. 4-બિટ ડાઉન કાઉન્ટર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો વેરિલોગ કોડ લખો.

જવાબ

ટેસ્ટબેંચ ઓવરવ્યુ:

કમ્પોનન્ટ	ઉદ્દેશ્ય	ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન
સ્ટિમ્યુલસ જનરેશન	ટેસ્ટ ઇનપુટ પ્રદાન કરવું	ક્લોક, રીસેટ, કંટ્રોલ સિગ્નલ
રિસ્પોન્સ મોનિટરિંગ	આઉટપુટ ચેક કરવું	અપેક્ષિત મૂલ્ય સાથે સરખાવો
કવરેજ એનાલિસિસ	સંપૂર્ણતા ચકાસવી	બધી સ્ટેટ અને ટ્રાન્ઝિશન
ડિબગિંગ સપોર્ટ	સમસ્યા ઓળખવી	વેવફોર્મ એનાલિસિસ

4-બિટ ડાઉન કાઉન્ટર:

```
module down\_counter\_4bit (  
    input wire clk, reset, enable,  
    output reg [3:0] count  
);  
  
always @(posedge clk or posedge reset) begin  
    if (reset) begin  
        count {=} 4{b1111}; //  
    end else if (enable) begin  
        if (count == 4{b0000})  
            count {=} 4{b1111}; //  
        else  
            count {=} count {-} 1; //  
    end  
end  
  
endmodule  
  
//  
module tb\_down\_counter;  
    reg clk, reset, enable;  
    wire [3:0] count;  
  
    down\_counter\_4bit dut (  
        .clk(clk),  
        .reset(reset),  
        .enable(enable),  
        .count(count)  
    );  
  
    //  
    always \#5 clk = {}clk;  
  
    initial begin  
        clk = 0;  
        reset = 1;  
        enable = 0;  
  
        \#10 reset = 0;  
        \#10 enable = 1;  
  
        \#200 $finish;  
    end  
  
    //  
    initial begin  
        $monitor("Time=\\%0t, Reset=\\%b, Enable=\\%b, Count=\\%b",  
            $time, reset, enable, count);  
    end  
  
endmodule
```

ટેસ્ટબેચ કમ્પોનન્ટ:

- કલોક જનરેશન: always બ્લોક વડે કંટિન્યુઅસ કલોક
- સિમ્યુલેશન: રીસેટ અને enable સિગ્નલ કંટ્રોલ
- મોનિટરિંગ: કંટિન્યુઅસ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે
- સિમ્યુલેશન કંટ્રોલ: સિમ્યુલેશન અંત કરવા માટે \$finish

કાઉન્ટર લક્ષણો:

- ડાઉન કાઉન્ટિંગ: 15 થી 0 સુધી ડેક્રિમેન્ટ
- રેપ અરાઉન્ડ: 0 પહોંચ્યા પછી 15 પર પાછું ફરે

- **enable કંટ્રોલ:** માત્ર enable હોય ત્યારે જ કાઉન્ટિંગ
- **સિંક્રોનસ ઓપરેશન:** કલોક એજ પર બધા ફેરફાર

મેમરી ટ્રીક

“ટેસ્ટબેંચ ટેસ્ટ કરે કલોક, સ્ટિમ્યુલસ અને મોનિટર સાથે”